Autoevaluación Unidad 2 - Memoria Principal - Presencial

El objetivo de este ejercicio es la autoevaluación de los contenidos expuestos a lo largo de la Unidad 2- Memoria Principal.

| ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los registros es falsa? |
|---|
| Seleccione una: |
| a. El registro es el espacio de memoria que se encuentra dentro del procesador. |
| b. Se utilizan celdas de memoria de tipo estático, SRAM, para su implementación. |
| c. Están integrados en el mismo chip del procesador. |
| d. Es una memoria que se sitúa entre la memoria Cache L1 y la memoria principal. |
| ¿Qué afirmación sobre la memoria SRAM es falsa? |
| Seleccione una: |
| O a. La memoria SRAM es más cara, pero más rápida y con un menor consumo (especialmente en reposo) que la memoria DRAM. |
| O b. Esta memoria es capaz de mantener los datos, mientras esté alimentada, sin necesidad de circuito de refresco. |
| C. Son memorias muy veloces, pero tienen poca capacidad de almacenamiento. |
| d. Es una memoria Estática de Acceso Aleatorio construida a base de condensadores. |
| : Cuál de las siguientes afirmaciones cobre la Velecidad efectival es correcto? |
| ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre 'la Velocidad efectiva' es correcta? |
| Seleccione una: |
| a. Es la latencia de una memoria. |
| b. Es generalmente calculado por la multiplicación del ancho del bus de datos por la frecuencia con la que transfiere datos. c. Sólo tiene sentido en memorias asíncronas. |
| d. Cuando se utilizan los flancos de subida y bajada, de un ciclo de reloj, para realizar operaciones en cada uno de ellos. |
| u. Cualituo se utilizari itos italicos de subida y bajada, de un cicio de reioj, para realizar operaciones en cada uno de enos. |
| La Memoria Principal es una memoria: |
| Seleccione una: |
| a. Todas las afirmaciones son correctas. |
| b. Donde se almacena información de forma permanente. |
| C. De solo lectura. |
| d. Volátil. |
| |
| ¿Cuál de las siguientes memorias utilizan ambos flancos, del ciclo de reloi, nara realizar las operaciones de lectura y escritura? |
| ¿Cuál de las siguientes memorias utilizan ambos flancos, del ciclo de reloj, para realizar las operaciones de lectura y escritura? |
| Seleccione una: |
| Seleccione una: O a. EDO |
| Seleccione una: a. EDO b. SDRAM |
| Seleccione una: a. EDO b. SDRAM c. DDR SDRAM |
| Seleccione una: a. EDO b. SDRAM |
| Seleccione una: a. EDO b. SDRAM c. DDR SDRAM |
| Seleccione una: a. EDO b. SDRAM c. DDR SDRAM d. FPM ¿Qué es la memoria ROM? |
| Seleccione una: a. EDO b. SDRAM c. DDR SDRAM d. FPM |
| Seleccione una: a. EDO b. SDRAM c. DDR SDRAM d. FPM ¿Qué es la memoria ROM? Seleccione una: |
| Seleccione una: a. EDO b. SDRAM c. DDR SDRAM d. FPM ¿Qué es la memoria ROM? Seleccione una: a. Es una memoria de solo lectura programable por el usuario, pudiéndose programar y borrar las veces que se desee. |
| Seleccione una: a. EDO b. SDRAM c. DDR SDRAM d. FPM ¿Qué es la memoria ROM? Seleccione una: a. Es una memoria de solo lectura programable por el usuario, pudiéndose programar y borrar las veces que se desee. b. Es una memoria que se programa durante el proceso de fabricación y no se puede borrar. |

| ¿Qué afirmación sobre DUAL, TRIPLE O QUAD CHANNEL en memorias RAM es falsa? |
|--|
| Seleccione una: |
| a. Para poder usar esta tecnología tiene que estar soportado por la placa base. |
| O b. Son tecnologías que permiten acceder a varios módulos de memoria al mismo tiempo. |
| C. Para poder usar esta tecnología tiene que estar soportado por el microprocesador. |
| d. Son tecnologías que permiten agrupar en un mismo encapsulado de memoria dos, tres o cuatro chip de memoria. |
| El número de ciclos de reloj que transcurren desde que la petición de datos es enviada hasta que los datos son transmitidos desde el módulo: |
| |
| Seleccione una: O a. Velocidad Física. |
| b. Latencia. |
| C. Velocidad efectiva. |
| O d. Ancho de Banda. |
| |
| Las memorias que no necesitan ser refrescadas cada cierto tiempo: |
| Seleccione una: |
| a. Están fabricadas con Condensadores. |
| b. Es muy utilizada en la memoria principal de los computadores personales. |
| c. Están fabricadas con Biestables. |
| O d. Son memorias DRAM. |
| |
| ¿Qué afirmación sobre el Tiempo de Ciclo de Memoria es cierta? |
| Seleccione una: |
| O a. No existe el Tiempo de Ciclo de Memoria es el Tiempo de Acceso de las memorias. |
| O b. Son los segundos que tarda en ejecutar un ciclo de reloj. |
| c. Es el tiempo que se transcurre desde que comienza una lectura o escritura hasta que se puede iniciar la siguiente. |
| d. Es el tiempo que tarda en realizar una operación de lectura o escritura, es decir, el tiempo que transcurre desde el instante en el que se presenta una |
| dirección a la memoria hasta que el dato, o ha sido memorizado o está disponible para su uso. |
| |
| ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la memoria caché L1 es cierta? |
| Seleccione una: |
| a. Es una memoria de tipo caché con velocidad intermedia entre la velocidad del procesador y la memoria RAM. |
| b. Es una memoria de tipo caché con mayor velocidad, velocidad próxima a la de la CPU, pero de espacio de almacenamiento muy grande |
| c. Es una memoria de tipo caché con mayor velocidad, velocidad próxima a la de la CPU, pero de espacio de almacenamiento reducido. |
| d. Es una memoria de tipo caché con velocidad más parecida a la velocidad de la memoria RAM. |
| Out the least of the second of |
| ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la Memoria Dinámica de Acceso Aleatorio es cierta? |
| Seleccione una: |
| a. Es una memoria SRAM construida a base de condensadores. |
| b. Es una memoria DRAM que necesita ser refrescada cada cierto tiempo. |
| c. Es una memoria DRAM construida a base de biestables. |
| Od. Es una memoria SRAM construida a base de biestables. |

| ¿Qué es la latencia CAS? |
|--|
| Seleccione una: |
| a. Latencia al activar la celda. |
| o b. Latencia al activar el tablero de memoria. |
| C. Latencia al activar la fila. |
| Od. Latencia al desactivar el tablero de memoria. |
| |
| Si tenemos una memoria DDR300 ¿Cuál sería su nomenclatura PCXXXX? |
| Seleccione una: |
| O a. PC1600 |
| O b. PC3200 |
| ○ c. PC2100 |
| ● d. PC2400 |
| |
| Si tenemos una memoria de 200 MHz ¿Cuántos segundos tarda en ejecutar un ciclo de reloj? |
| Seleccione una: |
| (a. 200 ns |
| ○ b. 0,5 segundos. |
| ⊙ c. 5 ns |
| O d. 1 segundo. |
| |
| En la memoria nos encontramos con: |
| Seleccione una: |
| a. Un registro de dirección de memoria y otro de instrucción. |
| ○ b. Un registro de instrucción y otro de control. |
| c. Un registro de dirección de memoria y otro de información de memoria. |
| O d. La ALU. |
| |
| La memoria ROM que es programable y borrable eléctricamente es: |
| Seleccione una: |
| a. La EEPROM. |
| ○ b. La EPROM. |
| ○ c. La ROM. |
| O. La PROM. |
| |
| ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el ciclo de reloj o velocidad del bus de las memorias es cierta? |
| Seleccione una: |
| a. Todas las afirmaciones son correctas. |
| b. A menor frecuencia mayor número de operaciones. |
| ○ c. Sólo tiene sentido en memorias asíncronas. |
| d. Marca la pauta para realizar una operación. |
| |
| La capacidad que posea el microprocesador para el direccionamiento de direcciones en memoria es determinada por: |
| Seleccione una: |
| a. El ancho del bus de direcciones. |
| |
| O b. Depende de la ALU. |
| b. Depende de la ALU. c. El ancho del bus de datos. |
| |